

会合名：第 19 回格子欠陥フォーラム「半導体格子欠陥の最前線」

主催：九州大学応用力学研究所

日時：2009 年 9 月 24 日（木）10 時から 16 時

場所：九州大学筑紫キャンパス応用力学研究所(福岡県春日市春日公園 6-1)

内容：半導体中の格子欠陥の最近の動向や進展に関して、一同に会して議論する。

講演者一覧（当日の発表順ではありません。確定版は追って案内します。）

金田 寛（新潟大物質量子セ）

低温超音波計測によるシリコン原子空孔評価—その物理と実用評価技術

斎藤峯雄（金沢大理工）

シリコン及びグラフェンにおける固有欠陥の第 1 原理計算

X. J. Chen（九大応用力学研）

一方向性凝固法による結晶内の点欠陥分布の数値解析

泉妻宏治（コバレントマテリアル）

半導体デバイス対応のシリコンウェーハ表面および表層解析

末岡浩治（岡山県立大）

(100)/(110)直接接合 Si 基板の界面構造とゲッターリング

桑野範之（九大産学連携セ）

TEM と SEM による微細構造解析

中島 寛（九大産学連携セ）

SiGe-On-Insulator 基板形成時に発生する欠陥の電気・光学的評価

田中 悟（九大院工）

SiC 上エピタキシャルグラフェンのドメイン構造

井上耕治（京大院工）

3次元アトムプローブによる MOSFET 中のドーパント分布解析

藤浪真紀（千葉大院工）

Si 中の原子空孔と Cu の相互作用に関する陽電子消滅研究

白井光雲（阪大産研）

シリコン中の Cu 不純物 —最近のトピックスから—

定員： 100 名

参加費：講演要旨集代 1,000 円

参加申込締切日：8 月 31 日（名前，所属，住所，メールアドレス，電話番号を下記まで電子メールでご連絡ください）

連絡先：九州大学応用力学研究所 大坪（柿本研究室）

Tel: 092-583-7745 Fax: 092-583-7743

E-mail: junko@riam.kyushu-u.ac.jp